	61 2	Формат	Зона	Поз	Обозначение			Наименование		Кол.	Приме— чание
	тен. 1613.002	*)			РЕУН.468349.001 СБ 2	?D		<u>Документация</u> Сборочный чертеж			*)Л <u>Л</u> , А4
	Перв. примен. РЕУН. 941613.	*)			PEYH.468349.001 93 2	?D) Схема электрическая принципиальная				*) Л <u>Л</u> , А4
-		*)			РЕУН.468349.001 ПЭЗ	<i>TЭ</i>		Перечень элементов			*)ЛД, А4
	~	*)			РЕУН.468349.001 ВП	<i>TЭ</i>		Ведомость покупных и	<i>зделий</i>		*)ЛД, А4
	Справ.							Сборочные едини	<u> </u>		
		*)		1	PEYH.687253.004 T9			Плата печатная		1	*)ЛД, А4
								Прочие изделия	Я		
	Подп. и дата							Конденсаторы фирма Yagec	р, Тайвань		
	Инв. N дубл.			3				CC0805JRNP09BN470		2	C28, C29
	Взам. инв. N И			5				CC0805KRX7R9BB472		2	C26, C27
	Подп. и дата — Вз			—	05///4 0007 1000 07			DEVII 160710) ///1		
Разраб.	Инв. И подл.	Изм. Лист N докум. Подп. Дата Разраб. Подлесный подп. 18.16.23 Пров. Шавликов подп. 18.16.23						РЕУН. 468349. 001 праспределения ППП питания			<u>Листов</u> 9
Pa3,	Z	<u> </u>	тв.	1	Цавликов подп. 18.16.23	Konı	ировал	- · · · - · · · - · · · · · · · · · · ·	Форма	im A4	

#00@	Зона	FOI	Обозначение	Наименование	кох	Приме- чание
				Конденсаторы фирма Samsung, Южная Корея		
		7		CL21C5R6CBANNNC	2	C54, C55
		9		CL31B225KBHNNNE	16	C16-C23
				GLOTIDZZONDI II VII VIVL	70	C42-C49
		11		CL32B226KOJNNNE	24	C30-C47
				Конденсаторы фирма Murata, Япония		
Nogn u gama		13		GRM21BR71H104KA01K	12	C3-C5, C8-C11,
						C15, C24,
Инв. № дубл.						C51
Взам. инв. № И		15		GRM21BR71H105KA12L	3	<i>C6, C7, C</i> 14
gama	_	17		GRM21BR71H154K	2	C12,C13
Nogn. u		19		GRM216R71H822KA01D	2	C52, C53
Инв.N подл.				PEYH. 468349.001		Ли

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			21		Микросхема L78L33ABUTR,	1	DA1
					фирма STMicroelectronics,		
					Швейцария		
			23		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4
					фирма Analog Devices, США		
			<i>25</i>		Muun a ayaya CN7411C12EDD	1	DD3
	-		20		Микросхема SN74HC125DR фирма NXP Semiconductors,		DDS
					Нидерланды Нидерланды		
					пидерлипуи		
	\vdash		27		M TDC5 45 CODD 4D	1	005 00
			2/		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD
3					фирма Texas Instruments, США		
il for i							
#0/h			29		Микросхема VN5016AJTR-E	2	DD1,DD2
7					фирма STMicroelectronics,		
					Швейцария		
:							
			31		Предохранитель плавкий	1	FU1
<u> </u>	-				189000.15, фирма SIBA,		устана
2					Германия		ливает
5							с поз.10
1601							
#/S	_						
		F	干	Г)[160710 001	$T \gamma$	Ли
	Изм	Лu	cm	N докум. Подп. Дата	PEYH. 468349. 001	ΙJ	

	Формат	Зона	Поз	Обозначение		Наименование	Кол	Приме– чание
	Ш							
	Щ							
			33			Предохранитель плавкий	1	FU2
	Ц					KLS5-1046-25000		устанав—
						фирма KLS Electronic, Китай		ливается
								с поз.101
	Ц		<i>35</i>			Предохранитель плавкий	2	FU3,FU4
						MF—MSMF050, фирма Bourns, США		
						Катушки индуктивности		
						фирма EPCOS, Германия		
	П							
מם			37			B82477G4153M000	2	L1,L2
u gama								
Togn. u								
110			39			B82477G4333M000	1	L3
дубл.								
N								
Инв.			41			B82477G4823M000	1	L4
× ×								
инв								
Взам.	\bigsqcup					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
	Ш							
gama	Щ							
2			43			RC0805FR-070RL	4	R26,R27,
Подп	Щ							R38,R39
	Щ							
подл								
Инв.И		<u> </u>	+		 D	EYH. 468349.001	Tコ	Лист
N.	Изм.	Лu	ст	N докум. Подп. Дата	 		IJ am A4	4

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			45		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R1.
			70		NCOODSI N-07 TOONL		R16,R19,
							R21,R25
							7127,7120
			47		D000055D 0740V0V		D 75 D 77
			47		RC0805FR-0710K2L	4	R35,R37,
							R47,R49
			49		RC0805FR-0710KL	13	R3–R6,
					, rossessivit syrenz		R11-R14,
							R17,R18,
							R20,R22,
							R23
gama							
Подп. и			51		RC0805FR-07100KL	1	R24
дубл							
>			53		RC0805FR-07143KL	2	R46,R48
Инв.							
инв. N			55		RC0805FR-0716K9L	2	R30,R31
Взам. и							,
			<i>57</i>		RC0805FR-071K2	2	R44,R45
n. u gama							
Подп.			<i>59</i>		RC0805FR-0723K7L	2	R42,R43
подл							
Инв.N подл	Изм.		cm N g	окум. Подп. Дата	PEYH. 468349.00	<i>1 TЭ</i>	Ли. 5

	Формап	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			61		RC0805FR-07243KL	4	R28,R29,
					1100003111 - 0724311L	7	R40,R41
			63		RC0805FR-072K7	2	R7,R8
			65		RC0805FR-07330RL	2	R32,R33
			67		RC0805FR-0753K6L	2	R34,R36
			69		D000055D 077745	0	D0 D10
<i></i>			09		RC0805FR-077K5	2	R9,R10
ı u gama			71		Диод B560C	4	VD16, VD17
l logn.					фирма Diodes Incorporated, США	7	VD10, VD17
you.							
MH0. N			73		Диод PESD5VOL1BA,115	2	VD13, VD1
UHO. N					фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
БЗАМ. И							
даша		\dashv	75		Диод PMEG3010BEA,115	2	VD7, VD8
<i>n</i>					фирма NXP Semiconductors,		
logn.					Нидерланды		
подл				1 1 1			
ино. и подл.	Изм.	Пи	cm /	N докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001	ТЭ	Лис 6

wondow	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
	\perp					
		77		Диод SM15T36A	4	VD1-VD4
				фирма STMicroelectronics,		
				Швейцария		
	+					
		79		Диод SMAJ15A	2	VD9, VD10
				фирма STMicroelectronics,		
				Швейцария		
	+					
		81		Диод SMAJ24A	2	VD11, VD1
				фирма STMicroelectronics,		,
				Швейцария		
\top	\mathbb{H}					
		83		Диод SMBJ5.A	2	<i>VD20, VD2</i>
				фирма STMicroelectronics,		
				Швейцария		
-		85		Диод SMBJ12A	2	VD26, VD2
	+			фирма STMicroelectronics,		VD20, VD2
	+			Швейцария		
\sqcap						
	Ш	87		CBemoguog TO-1608BC-PG	7	VD5, VD6,
s	Ш			фирма Taiwan Oasis Technology Co.,		<i>VD15, VD1</i>
	Ш			Китай		VD19, VD2
$\perp \!\!\! \perp$	+					VD25
	igspace	\dashv				<u> </u> Ли
	зм. Ли	1,,	юкум. Подп. Дата	PEYH.468349.001	<i>T.</i> Э	

	Формат	Зона	7/03	Обозначение	Наименование	Кол	Приме чание
			89		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
					фирма NXP Semiconductors,		
					Нидерланды		
-	4	-	\perp				
_	+		91		Транзистор IRF7509TRPBF	2	<i>VT1, VT2</i>
					фирма Infineon Technologies,		
	1	1			Германия		
			+				
			93		Вилка DS1066—2MVW6X	8	X3–X8,
					фирма Connfly, Kumaŭ		X15,X16
	+	1	95		Вилка DS1069—4MVW6X	4	X9-X12
-					фирма Connfly, Китай		
	1		97		Розетка XT60-F.G2.Y	2	X13,X14
					фирма Amass Electronics, Китай		·
_							
			99		Вилка XT60-M.G2.Y	2	X1,X2
	4				фирма Amass Electronics, Китай		
	_						
			101		Держатель предохранителя NF—005	4	устанав
	\prod				фирма RUICHI, Kumaŭ		ивается
\sqcup		1	\perp				c no3.33,
			\perp			<u></u>	<u> </u> Л
		Лис		I докум. Подп. Дата	PEYH. 468349. 001	TЭ	//

Номера листов (страниц) Всего вистов (страници) Всего вистов (с					Лист ре	егистраці	ии изменен	ий		
Thorn v gama Base wid M MilkN gales Thorn w gama Thorn w				ов (стран	ıuu)	Всего	Иомор	Входящий		
Thogn u gama Bsaw unt N Whith ayon u logn u	Изл	^{Л.} изменен— ных	заменен— ных	новых	анулиро— Ванных	јистов (страниц) в документе	помер документа	дительного документа и дата	Подпись	Дата
Togn u gama Bsam until N Whith gybia Ingan u										
Togn. u. gama Bsam. until N. Wh&N. gyba. Ingan. u.										
Togn u gama Bsom until N Whith gyba Ingan u										
Togn u gama Bsaw unß N WhâN gyba Inagn u Bsaw unß N WhâN gyba Inagn u										
Togn u gama Bsaw unß N WhâN gyba Inagn u Bsaw unß N WhâN gyba Inagn u										
Togn. u. gama Bsaw. until N Wh&N gyba. Ingn. u.										
Togn u gama Bsom until N Whith gyba Ingan u										
Togn u gama Bsaw unß N WhâN gyba Inagn u Bsaw unß N WhâN gyba Inagn u										
Togn. u. gama Bsam. until N. Wh&N. gyba. Ingan. u.										
Togn. u. gama Bsam. until N. Wh&N. gyba. Ingan. u.	<u>ama</u>									
Подп. и дота Взам. инб. N. Инб. N. Инб. N. Инб. N. Инб. N. И. И. О.	>									
Togn u gama B3am unth N) 									
Uodu n dama Baw nuth N N	dybn.									
Nogn. u gama B3aw.	MHØ.V									_
Nogn. u gama B3am	N									
Nogn. u gama	33am u									
T	<u>Ifooli</u>									
>	ngon								<u> </u>	<u> </u>
PEYH. 468349.001 T3	UHB N				/	PEYH. 4	168349	9.001 7	- Э	Лист 9